

# Flash 地址对齐

表中列出常用芯片的基地址对齐信息汇总，PowerWriter 适配的大部分芯片支持单字节对齐，也即无须额外对齐，Power Writer对于没有对齐到下表的用户固件，回读数据并对齐写入，此功能绝大部分时候都是可行的，但部分芯片不支持多次写入，比如 **STM32H7**，为了保证用户能正常烧写芯片，按表中对齐固件依然是最佳的选择方案，此表仅供查询参考：

芯片系列	FLASH 基地址	支持对齐方式
STM32F0xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 2 字节对齐
STM32F1xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 2 字节对齐
STM32F2xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
STM32F3xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 2 字节对齐
STM32F4xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
STM32F7xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
STM32L0xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
STM32L1xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
STM32L4xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 8 字节对齐
STM32L5xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 8 字节对齐
STM32G0xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
STM32G4xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 8 字节对齐
STM32WBxx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 8 字节对齐
STM32H7xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 32 字节对齐
GD32F10x	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32F1x0	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32F20x	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32F30x	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32F3x0	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32F4xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32E230	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
GD32E103	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
MM32F00x	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐

芯片系列	FLASH 基地址	支持对齐方式
MM32F1xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
MM32L0xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
MM32L3xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
MM32SPINxx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
MM32W0xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
MM32W3xx	0x08000000	相对于 FLASH 基地址 4 字节对齐
...	...	...

:::caution 注意

Power Writer 将对其信息已经进行自动处理，在添加固件时如果没对齐到首地址，将会报错，并无法添加固件。

:::

对其信息后续将不会继续添加维护，重点在于介绍芯片的写入方式，有一个概念性的了解。

:::tip 提示

[下载本页PDF文件](#)

:::